

Моделирование анизотропии усиления, наведенной линейно поляризованным излучением накачки, в биполяризационном Nd:YAG-лазере

Н.Д.Миловский, П.А.Хандохин

Предложена модель биполяризационного твердотельного Nd:YAG-лазера, учитывающая реальную ориентацию поглощающих и излучающих диполей активных центров Nd^{3+} в элементарной ячейке алюмоиттриевого граната, которая описывает экспериментально наблюдавшийся эффект анизотропии усиления, наведенной линейно поляризованным излучением накачки. Модель предсказывает новый вид неустойчивости, обусловленный наличием двух конкурирующих каналов накачки, не обсуждавшийся ранее в литературе.

Ключевые слова: лазер, поляризационная мода, наведенная анизотропия усиления, релаксационные колебания.

1. Введение

Создание твердотельных лазеров с полупроводниковой накачкой линейно поляризованным излучением позволило провести детальное исследование их поляризационных свойств. При малой амплитудной анизотропии и достаточно большом превышении накачкой порогового значения, как правило, наблюдается одновременная генерация на ортогонально поляризованных модах. Эти режимы генерации были обнаружены при исследовании первых микроциповых Nd:YAG-лазеров [1] и волоконных лазеров, активированных ионами неодима [2, 3] и эрбия [4]. Изучение режимов генерации на ортогонально поляризованных модах в биполяризационных лазерах способствует решению различных фундаментальных и прикладных задач. В частности, такие лазеры могут применяться в телекоммуникациях, спектроскопии, доплеровских измерителях скорости, виброметрии, при создании оптических компьютеров и оптико-микроволновых систем, для засекречивания данных и т. д. [5]. Эти примеры указывают на важность и актуальность исследований влияния взаимодействия поляризационных мод на динамику лазерной генерации [6].

Особый интерес представляет случай, когда доминирующий тип анизотропии обусловлен анизотропией усиления, наведенной линейно поляризованным излучением накачки. Такая наведенная анизотропия усиления наблюдается в лазерах на красителях [7–9] и в твердотельных лазерах [1–3, 10–18]. Этот эффект проявлялся в зависимости порогов генерации и интенсивностей поляризационных мод от ориентации поляризации излучения накачки. «Сильной» поляризационной моде соответствовало положение анализатора, при котором интенсивность про-

шедшего излучения была максимальной, а «слабой» – ортогональное положение анализатора, при котором интенсивность прошедшего излучения была минимальной. Вращение плоскости поляризации накачки приводит к противофазному изменению интенсивностей поляризационных мод I_1 и I_2 с периодом, равным 180° .

Для объяснения экспериментальных результатов в работах [12–16] была предложена модель лазера с инерционной активной средой (лазеры класса В по классификации Ареки [19]), в основу которой легли упрощающие предположения о равномерном угловом распределении линейно поляризованных дипольных моментов активных центров в ортогональной оси резонатора плоскости. В рамках этой модели удалось интерпретировать экспериментально обнаруженные нами зависимости интенсивностей ортогонально поляризованных мод волоконного лазера и Nd:YAG-лазера от поляризации поля лазерной накачки и объяснить наличие противофазных колебаний интенсивностей ортогонально поляризованных мод. В работах [20, 21] рассматривалась альтернативная модель, в которой предлагалось считать эти диполи линейно поляризованными и ориентированными по кристаллографическим осям. Несмотря на хорошее согласие теории с экспериментом остается сомнение относительно полной адекватности этих моделей описанию динамики Nd:YAG-лазеров.

Поскольку в целом кристалл является кубическим, то каждая его элементарная ячейка содержит ионы иттрия, локализованные в шести четко ориентированных состояниях с D_2 -симметрией. Каждый из указанных ионов может быть замещен ионом неодима Nd^{3+} . Симметрия этих состояний схематично представлена на рис. 1, где p_i , q_i и r_i ($i = 1, 2, 3$) – локальные ортогональные оси C_2 -симметрии [22, 23]. Дипольные моменты ориентированы вдоль данных осей в соответствии с правилами отбора для магнито- и электродипольных переходов. Это согласуется с работами Феофилова [24, 25], в которых показано, что излучающие и поглощающие диполи ориентируются по осям симметрии активных центров, которые не всегда совпадают с кристаллографическими осями.

Все поглощающие и лазерные (излучающие) электродипольные переходы формируются между мультиплетами

Н.Д.Миловский. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Россия, 603950 Н.Новгород, просп. Гагарина, 23; e-mail: mil1940@mail.ru
П.А.Хандохин. Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН, Россия, 603950 Н.Новгород, ул. Ульянова, 46; e-mail: khando@appl.sci-nnov.ru

Поступила в редакцию 31 августа 2018 г., после доработки – 22 ноября 2018 г.

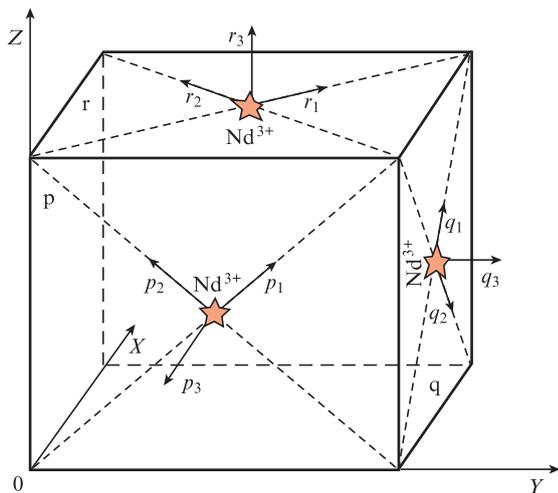


Рис.1. Схема возможных положений активных ионов в элементарной ячейке кристаллической матрицы алюмоиттриевого граната (YAG).

ми: $^4I_{9/2} - ^2H_{9/2}$, $^4I_{9/2} - ^4F_{5/2}$ и $^4F_{3/2} - ^4I_{11/2}$ [26]. Они имеют определенные поляризационные состояния в соответствии с правилами отбора и определенные пространственные ориентации относительно кристаллографических осей. При лазерной накачке на длине волны 810 нм в процессе возбуждения активной среды участвуют мультиплеты $^4F_{5/2}$ и $^2H_{9/2}$. На рис.2 изображены все возможные переходы, отвечающие процессу поглощения излучения накачки. Ширина зоны поглощения в области 810 нм составляет примерно 10 нм [27]. Несмотря на отсутствие точной информации о величине вклада каждого перехода в процесс поглощения накачки, можно с уверенностью утверждать, что в нем могут участвовать переходы с линейно ($\Delta J_z = 0$) и циркулярно ($\Delta J_z = \pm 1$) поляризованными дипольными моментами. Поэтому при вычислении населенностей верхних рабочих уровней [7, 15, 28] необходимо учитывать взаимодействие поляризованного излучения накачки с линейно (π) и циркулярно (σ) поляризованными дипольными моментами поглощающих переходов. Несколько иначе обстоит дело с лазерными переходами. На рис.3 показаны оба перехода, дающие вклад в линию излучения на $\lambda = 1064$ нм. Видно, что оба они являются σ -переходами.

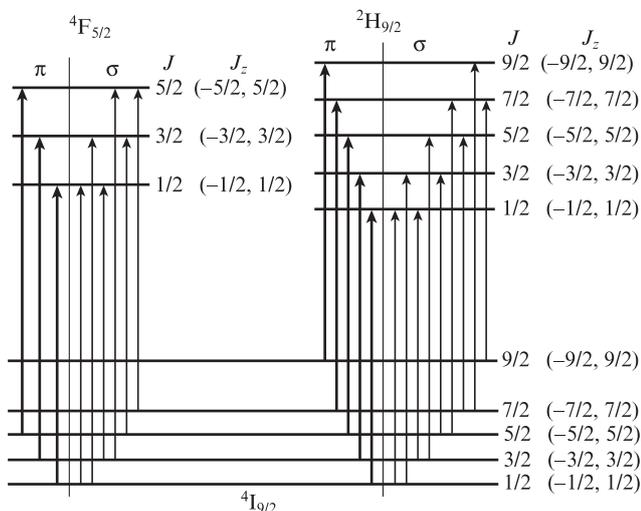


Рис.2. Возможные переходы, отвечающие процессу поглощения излучения накачки.

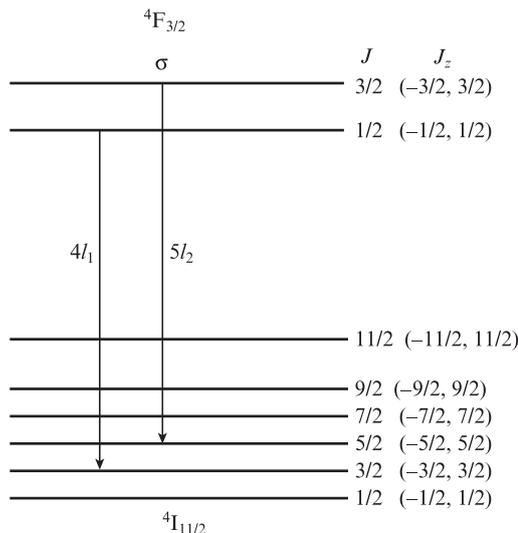


Рис.3. Лазерные переходы, дающие вклад в линию излучения на $\lambda = 1064$ нм.

В Nd:YAG-лазере эллиптически поляризованные ортогональные моды генерируются независимо от пространственной структуры их поля, которая определяется типом используемого резонатора (кольцевого или Фабри-Перо). Причиной этого могут быть неплоскость контура кольцевого резонатора [29] либо остаточное двулучепреломление рабочего кристалла [30].

В настоящей работе предлагается модель биполяризационного Nd:YAG-лазера на основе резонатора Фабри-Перо, в которой при описании взаимодействий с поляризованным полем накачки и полями эллиптически поляризованных ортогональных мод учитываются реальные поляризационные свойства резонансных переходов девяти различных групп активных ионов в элементарной ячейке кристаллической матрицы (рис.1).

2. Модель Nd:YAG-лазера с продольной поляризованной накачкой

В рассматриваемой модели поле поляризованного излучения лазера накачки с частотой ω_p

$$E_p = (1/2)|E_p|e_p^0 \exp(i\omega_p t) + \text{с. с.}, \tag{1}$$

где $e_p^0 = y^0 \cos \Psi_p + z^0 \sin \Psi_p$, распространяется вдоль оси резонатора, совпадающей с кристаллографической осью X (рис.4). Ориентация кристалла [100]. Будем полагать, что осуществляется одночастотная генерация на двух ортогонально поляризованных продольных модах резонатора,

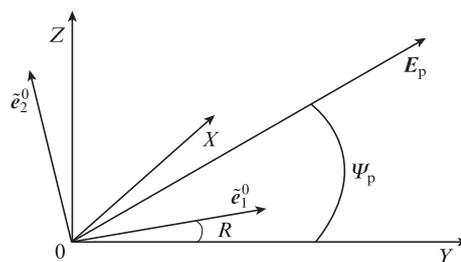


Рис.4. Взаимная ориентация главных осей эллипсов поляризаций генерируемых поляризационных мод и кристаллографических осей активного элемента.

$$\mathbf{E} = (1/2)(\tilde{E}_1\tilde{U}_1 + \tilde{E}_2\tilde{U}_2)\exp(i\omega t) + \text{с. с.}, \quad (2)$$

имеющих одинаковую пространственную структуру поля

$$\tilde{U}_m = \sqrt{2}\tilde{e}_m^0\cos(kx) \quad (3)$$

и ортогональные орты \tilde{e}_m^0 двух собственных поляризаций: $\tilde{e}_1^0\tilde{e}_2^{0*} = \tilde{e}_1^{0*}\tilde{e}_2^0 = 0$. Здесь $\tilde{E}_{1,2}$ – медленно меняющиеся комплексные амплитуды ортогонально поляризованных полей; ω и k – несущая частота и волновое число генерируемых колебаний. Каждый орт $\tilde{e}_{1,2}^0$ в общем случае можно представить в виде суммы двух проекций на направления $\mathbf{y}^{0'}$ и $\mathbf{z}^{0'}$ главных осей эллипсов собственных поляризаций лазерного поля:

$$\tilde{e}_1^0 = \mathbf{y}^{0'}\cos\vartheta + i\mathbf{z}^{0'}\sin\vartheta, \quad (4)$$

$$\tilde{e}_2^0 = i\mathbf{y}^{0'}\sin\vartheta + \mathbf{z}^{0'}\cos\vartheta, \quad (5)$$

где угол ϑ определяет параметр эллиптичности поляризационных мод $\varepsilon = |\tan\vartheta|^2$.

Введем угол R между главными осями эллипсов поляризаций генерируемых мод и соответствующими кристаллографическими осями активного элемента (рис.4), так что орты будут связаны соотношениями

$$\mathbf{x}^{0'} = \mathbf{x}^0, \quad \mathbf{y}^{0'} = \mathbf{y}^0\cos R + \mathbf{z}^0\sin R, \quad \mathbf{z}^{0'} = -\mathbf{y}^0\sin R + \mathbf{z}^0\cos R. \quad (6)$$

В проекциях на кристаллографические оси орты поляризаций генерируемых мод (4) и (5) можно представить в виде

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1^0 &= \mathbf{y}^0(\cos R \cos\vartheta - i\sin R \sin\vartheta) \\ &+ \mathbf{z}^0(\sin R \cos\vartheta + i\cos R \sin\vartheta), \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_2^0 &= \mathbf{y}^0(i\cos R \sin\vartheta - \sin R \cos\vartheta) \\ &+ \mathbf{z}^0(\cos R \cos\vartheta + i\sin R \sin\vartheta). \end{aligned} \quad (8)$$

Динамика биполяризационного лазера может быть описана следующей системой уравнений [15]:

$$\begin{aligned} \frac{dE_m}{d\tau} &= i(-1)^m E_m \delta - \frac{G}{2} E_m + \frac{G}{L} \sum_s \int_x [(e_L^{\sigma+s} \mathbf{E}) N_+^s (e_L^{\sigma+s} \tilde{U}_m)^* \\ &+ (e_L^{\sigma-s} \mathbf{E}) N_-^s (e_L^{\sigma-s} \tilde{U}_m)^*] dx, \quad m = 1, 2, \end{aligned} \quad (9)$$

$$\frac{\partial N_{\pm}^s}{\partial \tau} = gA_s - N_{\pm}^s (1 + |e_L^{\sigma+s} \mathbf{E}|^2), \quad s = p_1, p_2, p_3, q_1, q_2, q_3, r_1, r_2, r_3,$$

где

$$\begin{aligned} A_s &\equiv A_s^{\pi} + \frac{1}{2}(A_s^{\sigma_+} + A_s^{\sigma_-}) = \frac{b_1 |e_p^0 e_a^{\pi s}|^2}{b_1 |e_p^0 e_a^{\pi s}|^2 + 1} \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{b_2 |e_p^0 e_a^{\sigma_+ s}|^2}{b_2 |e_p^0 e_a^{\sigma_+ s}|^2 + 1} + \frac{b_2 |e_p^0 e_a^{\sigma_- s}|^2}{b_2 |e_p^0 e_a^{\sigma_- s}|^2 + 1} \right); \end{aligned} \quad (10)$$

полусумма $(A_s^{\sigma_+} + A_s^{\sigma_-})/2$ берется из соображений равновероятности вклада от право- и левополяризованных диполей: один циркулярно поляризованный активный центр

может дать либо правополяризованный, либо левополяризованный вклад; $\tau = t/T_1$; $G = T_1/T_c$; $g = T_1/\tau_2$; T_1, T_c, τ_2 – времена жизни инверсии населенностей, поля в резонаторе и верхнего уровня поглощающего перехода соответственно; $\delta = (\omega_{\xi}^{(1)} - \omega_{\xi}^{(2)})T_1$; $\omega_{\xi}^{(1),(2)}$ – собственные частоты поляризационных мод, которые в отсутствие фазовой анизотропии резонатора совпадают; L – длина резонатора.

Переход от нелинейных дифференциальных уравнений (9), в которых неизвестная функция $N_{\pm}^s(\tau, x)$ имеет пространственную зависимость, к системе уравнений в обыкновенных производных приводит к системе уравнений бесконечно высокого порядка (из-за бесконечно большого числа пространственных гармоник инверсии населенностей $N_{lk}^{\pm s}$, $l = 0, 1, \dots, \infty$). Для целей настоящего исследования бесконечный ряд гармоник инверсии населенностей следует ограничить только теми гармониками инверсии населенностей, которые в явном виде входят в уравнения для полей:

$$N_0^{\pm s} = \frac{1}{L} \int_0^L N_{\pm}^s dx, \quad N_k^{\pm s} = -\frac{1}{L} \int_0^L N_{\pm}^s \cos(2kx) dx.$$

В отличие от работы [15], в которой поглощающие диполи предполагались линейно поляризованными и равномерно распределенными по азимуту Ψ в перпендикулярной оси резонатора плоскости, здесь учитывается реальное состояние поляризации поглощающих диполей как на π -, так и на σ -переходах. В связи с этим вместо одного параметра b в [15] в (10) присутствуют два параметра – b_1 и b_2 :

$$\begin{aligned} b_1 &= b_1^0 A = \frac{\tau_2 T_a^{\pi} |\mu_a^{\pi}|^2}{\hbar^2} \text{Re} L_a^{\pi} |E_p|^2, \\ b_2 &= b_2^0 A = \frac{\tau_2 T_a^{\sigma} |\mu_a^{\sigma_{\pm}}|^2}{\hbar^2} \text{Re} L_a^{\sigma_{\pm}} |E_p|^2, \end{aligned} \quad (11)$$

где $A = |E_p|^2$ – параметр накачки; $L_a^{\pi, \sigma_{\pm}} = [1 - i(\omega_p - \omega_{a0}^{\pi, \sigma_{\pm}}) \times T_a^{\pi, \sigma_{\pm}}]^{-1}$; $\mu_a^{\pi, \sigma_{\pm}}$, $\omega_{a0}^{\pi, \sigma_{\pm}}$, $(T_a^{\pi, \sigma_{\pm}})^{-1}$ – дипольные моменты, центральные частоты и полуширины однородных линий поглощения соответствующих переходов. Кроме того, интегрирование по всем равномерно распределенным по азимуту Ψ дипольным моментам в [15] заменяется в (9) суммированием по девяти группам активных центров, имеющих вполне определенную фиксированную ориентацию поглощающих и излучающих дипольных моментов. Ниже приведены выражения для ортов линейно и циркулярно поляризованных дипольных моментов поглощающих переходов активных центров, расположенных в гранях p , q и r (см. вывод этих выражений в Приложении):

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_a^{\pi p_1} &= (\mathbf{y}^0 + \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}, & \mathbf{e}_a^{\sigma_+ p_1} &= \frac{\mathbf{x}^0 \mp i(\mathbf{y}^0 - \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, \\ \mathbf{e}_a^{\pi p_2} &= (-\mathbf{y}^0 + \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}, & \mathbf{e}_a^{\sigma_- p_2} &= \frac{\mathbf{x}^0 \pm i(\mathbf{y}^0 + \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, \\ \mathbf{e}_a^{\pi p_3} &= -\mathbf{x}^0, & \mathbf{e}_a^{\sigma_+ p_3} &= (\mathbf{y}^0 \pm i\mathbf{z}^0)/\sqrt{2}, \\ \mathbf{e}_a^{\pi q_1} &= (\mathbf{x}^0 + \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}, & \mathbf{e}_a^{\sigma_- q_1} &= \frac{\mathbf{y}^0 \mp i(\mathbf{x}^0 - \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, \\ \mathbf{e}_a^{\pi q_2} &= (-\mathbf{x}^0 + \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}, & \mathbf{e}_a^{\sigma_+ q_2} &= \frac{\mathbf{y}^0 \pm i(\mathbf{x}^0 + \mathbf{z}^0)/\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned}
 e_a^{\pi q_3} &= y^0, & e_a^{\sigma_{\pm} q_3} &= (x^0 \pm iz^0)/\sqrt{2}, \\
 e_a^{\pi r_1} &= (x^0 + y^0)/\sqrt{2}, & e_a^{\sigma_{\pm} r_1} &= \frac{z^0 \pm i(x^0 - y^0)/\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, \\
 e_a^{\pi r_2} &= (x^0 - y^0)/\sqrt{2}, & e_a^{\sigma_{\pm} r_2} &= \frac{z^0 \pm i(x^0 + y^0)/\sqrt{2}}{\sqrt{2}}, \\
 e_a^{\pi r_3} &= z^0, & e_a^{\sigma_{\pm} r_3} &= (x^0 \pm iy^0)/\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

Орты излучающих диполей совпадают с ортами циркулярно поляризованных поглощающих диполей:

$$e_L^{\sigma_{\pm} s} = e_a^{\sigma_{\pm} s}, \quad s = p_1, p_2, p_3, q_1, q_2, q_3, r_1, r_2, r_3. \quad (13)$$

Используя выражения (12) и (1), можем найти вклад от каждой группы активных центров в параметр A_s (10):

$$\begin{aligned}
 A_{p_1} &= \frac{b_1(1 + \sin 2\Psi_p)}{2 + b_1(1 + \sin 2\Psi_p)} + \frac{b_2(1 - \sin 2\Psi_p)}{4 + b_2(1 - \sin 2\Psi_p)}, \\
 A_{p_2} &= \frac{b_1(1 - \sin 2\Psi_p)}{2 + b_1(1 - \sin 2\Psi_p)} + \frac{b_2(1 + \sin 2\Psi_p)}{4 + b_2(1 + \sin 2\Psi_p)}, \\
 A_{p_3}^{\sigma} &= \frac{b_2}{2 + b_2}, \\
 A_q &= A_{q_1} = A_{q_2} = \frac{b_1(1 - \cos 2\Psi_p)}{2 + b_1(1 - \cos 2\Psi_p)} + \frac{b_2(3 + \cos 2\Psi_p)}{8 + b_2(3 + \cos 2\Psi_p)}, \\
 A_{q_3} &= \frac{b_1(1 + \cos 2\Psi_p)}{2 + b_1(1 + \cos 2\Psi_p)} + \frac{b_2(1 - \cos 2\Psi_p)}{4 + b_2(1 - \cos 2\Psi_p)}, \\
 A_r &= A_{r_1} = A_{r_2} = \frac{b_1(1 + \cos 2\Psi_p)}{4 + b_1(1 + \cos 2\Psi_p)} + \frac{b_2(3 - \cos 2\Psi_p)}{8 + b_2(3 - \cos 2\Psi_p)}, \\
 A_{r_3} &= \frac{b_1(1 - \cos 2\Psi_p)}{2 + b_1(1 - \cos 2\Psi_p)} + \frac{b_2(1 + \cos 2\Psi_p)}{4 + b_2(1 + \cos 2\Psi_p)}.
 \end{aligned} \quad (14)$$

Подстановка выражений (13) и (14) в (9) приводит к системе уравнений, которую можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned}
 \frac{dE_1}{d\tau} &= -iE_1\delta - \frac{G}{2}E_1 + \frac{G}{4}(U_1E_1 + U_{12}E_2), \\
 \frac{dE_2}{d\tau} &= iE_2\delta - \frac{G}{2}E_2 + \frac{G}{4}(U_{12}^*E_1 + U_2E_2), \\
 \frac{dN_0^{p_1}}{d\tau} &= 2A_{p_1} - N_0^{p_1} - \frac{1}{4}(N_0^{p_1} + N_k^{p_1}) \\
 &\quad \times (XQ - RscXD - RcXR + RssXI), \\
 \frac{dN_k^{p_1}}{d\tau} &= -N_k^{p_1} - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}N_0^{p_1} + N_k^{p_1}\right) \\
 &\quad \times (XQ - RscXD - RcXR + RssXI), \\
 \frac{dN_0^{p_2}}{d\tau} &= 2A_{p_2} - N_0^{p_2} - \frac{1}{4}(N_0^{p_2} + N_k^{p_2}) \\
 &\quad \times (XQ + RscXD + RcXR - RssXI),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dN_k^{p_2}}{d\tau} &= -N_k^{p_2} - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}N_0^{p_2} + N_k^{p_2}\right) \\
 &\quad \times (XQ + RscXD + RcXR - RssXI), \\
 \frac{dN_0^{+p_3}}{d\tau} &= A_{p_3} - N_0^{+p_3} - \frac{1}{2}(N_0^{-p_3} + N_k^{-p_3}) \\
 &\quad \times (XQ + TsXD - TcXI), \\
 \frac{dN_k^{+p_3}}{d\tau} &= -N_k^{+p_3} - \frac{1}{2}(N_0^{+p_3} + N_k^{+p_3})(XQ + TsXD - TcXI), \\
 \frac{dN_0^{-p_3}}{d\tau} &= A_{p_3} - N_0^{-p_3} - \frac{1}{2}(N_0^{-p_3} + N_k^{-p_3}) \\
 &\quad \times (XQ + TsXD - TcXI), \\
 \frac{dN_k^{-p_3}}{d\tau} &= -N_k^{-p_3} - \frac{1}{2}(N_0^{-p_3} + N_k^{-p_3})(XQ + TsXD + TcXI), \\
 \frac{dN_0^{+q}}{d\tau} &= 2A_q - N_0^{+q} - \frac{1}{8}(N_0^{+q} + N_k^{+q}) \\
 &\quad \times [3XQ + (Rcc - 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR - (Rcs + 2\sqrt{2}Tc)XI], \\
 \frac{dN_k^{+q}}{d\tau} &= -N_0^{+q} - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}N_0^{+q} + N_k^{+q}\right) \\
 &\quad \times [3XQ + (Rcc - 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR - (Rcs + 2\sqrt{2}Tc)XI], \\
 \frac{dN_0^{-q}}{d\tau} &= 2A_q - N_0^{-q} - \frac{1}{8}(N_0^{-q} + N_k^{-q}) \\
 &\quad \times [3XQ + (Rcc - 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR - (Rcs - 2\sqrt{2}Tc)XI], \\
 \frac{dN_k^{-q}}{d\tau} &= -N_0^{-q} - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}N_0^{-q} + N_k^{-q}\right) \\
 &\quad \times [3XQ + (Rcc - 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR - (Rcs - 2\sqrt{2}Tc)XI], \\
 \frac{dN_0^{q_3}}{d\tau} &= 2A_{q_3} - N_0^{q_3} - \frac{1}{4}(N_0^{q_3} + N_k^{q_3}) \\
 &\quad \times (XQ - RccXD + RsXR - RcsXI), \\
 \frac{dN_k^{q_3}}{d\tau} &= -N_0^{q_3} + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}N_0^{q_3} + N_k^{q_3}\right) \\
 &\quad \times (XQ - RccXD + RsXR - RcsXI), \\
 \frac{dN_0^{+r}}{d\tau} &= 2A_r - N_0^{+r} - \frac{1}{8}(N_0^{+r} + N_k^{+r}) \\
 &\quad \times [3XQ - (Rcc + 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR + (Rcs - 2\sqrt{2}Tc)XI], \\
 \frac{dN_k^{+r}}{d\tau} &= -N_k^{+r} - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}N_0^{+r} + N_k^{+r}\right) \times \\
 &\quad \times [3XQ - (Rcc + 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR + (Rcs - 2\sqrt{2}Tc)XI],
 \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \frac{dN_0^{-r}}{d\tau} &= 2A_r - N_0^{-r} - \frac{1}{8}(N_0^{-r} + N_k^{-r}) \\ &\times [3XQ - (Rcc - 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR + (Rcs + 2\sqrt{2}Tc)XI], \\ \frac{dN_k^{-r}}{d\tau} &= -N_k^{-r} - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}N_0^{-r} + N_k^{-r}\right) \\ &\times [3XQ - (Rcc - 2\sqrt{2}Ts)XD + RsXR + (Rcs + 2\sqrt{2}Tc)XI], \\ \frac{dN_0^{r3}}{d\tau} &= 2A_{r3} - N_0^{r3} - \frac{1}{4}(N_0^{r3} + N_k^{r3}) \\ &\times [XQ + RccXD - RsXR - (Rcs + 2\sqrt{2}Tc)XI], \\ \frac{dN_k^{r3}}{d\tau} &= -N_k^{r3} - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}N_0^{r3} + N_k^{r3}\right) \\ &\times [XQ + RccXD - RsXR - (Rcs + 2\sqrt{2}Tc)XI]. \end{aligned}$$

Здесь учтено, что для некоторых переменных уравнения совпадают в силу выбранной ориентации кристалла [100]. Это позволяет уменьшить размерность системы уравнений:

$$\begin{aligned} N_{0,k}^{p1} &= N_{0,k}^{+p1} + N_{0,k}^{-p1}, & N_{0,k}^{p2} &= N_{0,k}^{+p2} + N_{0,k}^{-p2}, \\ N_{0,k}^{+q} &= N_{0,k}^{+q1} + N_{0,k}^{+q2}, & N_{0,k}^{-q} &= N_{0,k}^{-q1} + N_{0,k}^{-q2}, \\ N_{0,k}^{+r} &= N_{0,k}^{+r1} + N_{0,k}^{+r2}, & N_{0,k}^{-r} &= N_{0,k}^{-r1} + N_{0,k}^{-r2}, \\ N_{0,k}^{q3} &= N_{0,k}^{+q3} + N_{0,k}^{-q3}, & N_{0,k}^{r3} &= N_{0,k}^{+r3} + N_{0,k}^{-r3}. \end{aligned}$$

В (15) введены обозначения для коэффициентов усиления ортогональных мод U_1, U_2 и коэффициентов их нелинейной связи $U_{12}, U_{21} = U_{12}^*$:

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{1}{2}(N_0^{p1} + N_k^{p1} + N_0^{p2} + N_k^{p2}) \\ &+ \frac{1}{2}\text{Rsc}[(N_0^{p2} + N_k^{p2}) - (N_0^{p1} + N_k^{p1})] \\ &+ \frac{1}{4}\text{Rcp}(N_0^{+q} + N_k^{+q} + N_0^{-q} + N_k^{-q}) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{2}\text{Ts}[(N_0^{-q} + N_k^{-q}) - (N_0^{+q} + N_k^{+q})] \\ &+ \frac{1}{4}\text{Rcm}(N_0^{+r} + N_k^{+r} + N_0^{-r} + N_k^{-r}) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{2}\text{Ts}[(N_0^{-r} + N_k^{-r}) - (N_0^{+r} + N_k^{+r})] \\ &+ (1 - \text{Ts})(N_0^{+p3} + N_k^{+p3}) + (1 + \text{Ts})(N_0^{-p3} + N_k^{-p3}) \\ &+ \frac{1}{2}(1 - \text{Rcc})(N_0^{q3} + N_k^{q3}) + \frac{1}{2}(1 + \text{Rcc})(N_0^{r3} + N_k^{r3}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{1}{2}(N_0^{p1} + N_k^{p1} + N_0^{p2} + N_k^{p2}) + \\ &+ \frac{1}{2}\text{Rsc}[(N_0^{p1} + N_k^{p1}) - (N_0^{p2} + N_k^{p2})] \\ &+ \frac{1}{4}\text{Rcm}(N_0^{+q} + N_k^{+q} + N_0^{-q} + N_k^{-q}) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{2}\text{Ts}[(N_0^{+q} + N_k^{+q}) - (N_0^{-q} + N_k^{-q})] \\ &+ \frac{1}{4}\text{Rcp}(N_0^{+r} + N_k^{+r} + N_0^{-r} + N_k^{-r}) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{2}\text{Ts}[(N_0^{+r} + N_k^{+r}) - (N_0^{-r} + N_k^{-r})] \\ &+ (1 + \text{Ts})(N_0^{+p3} + N_k^{+p3}) + (1 - \text{Ts})(N_0^{-p3} + N_k^{-p3}) \\ &+ \frac{1}{2}(1 + \text{Rcc})(N_0^{q3} + N_k^{q3}) + \frac{1}{2}(1 - \text{Rcc})(N_0^{r3} + N_k^{r3}), \end{aligned}$$

$$\text{Re } U_{12} = \frac{1}{2}\text{Rc}[(N_0^{p2} + N_k^{p2}) - (N_0^{p1} + N_k^{p1})] \quad (16)$$

$$\begin{aligned} &+ \frac{1}{4}\text{Rs}[(N_0^{+q} + N_k^{+q}) + (N_0^{-q} + N_k^{-q}) + (N_0^{+r} + N_k^{+r}) \\ &+ (N_0^{-r} + N_k^{-r}) + 2(N_0^{q3} + N_k^{q3}) - 2(N_0^{r3} + N_k^{r3})], \end{aligned}$$

$$\text{Im } U_{12} = \frac{1}{2}\text{Rss}[(N_0^{p2} + N_k^{p2}) - (N_0^{p1} + N_k^{p1})]$$

$$\begin{aligned} &+ \frac{1}{4}\text{Rcs}[(N_0^{+q} + N_k^{+q} + N_0^{-q} + N_k^{-q} + N_0^{+r} + N_k^{+r} + N_0^{-r} + N_k^{-r}) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{2}\text{Tc}[(N_0^{+q} + N_k^{+q} + N_0^{-r} + N_k^{-r}) \\ &- (N_0^{-q} + N_k^{-q} + N_0^{+r} + N_k^{+r})] \\ &+ \text{Tc}[(N_0^{+p3} + N_k^{+p3}) - (N_0^{-p3} + N_k^{-p3})] \\ &+ \frac{1}{2}\text{Rcs}(N_0^{q3} + N_k^{q3} + N_0^{r3} + N_k^{r3}), \end{aligned}$$

а также следующие обозначения:

$$XQ = |E_1|^2 + |E_2|^2, \quad XD = |E_1|^2 - |E_2|^2, \quad XR = E_1^*E_2 + E_2^*E_1,$$

$$XI = i(E_1E_2^* - E_1^*E_2), \quad \text{Rsc} = \sin 2R \cos 2\vartheta, \quad \text{Rss} = \sin 2R \sin 2\vartheta,$$

$$\text{Rc} = \cos 2R, \quad \text{Rcc} = \cos 2R \cos 2\vartheta, \quad \text{Rcp} = 3 + \text{Rcc},$$

$$\text{Rcs} = \cos 2R \sin 2\vartheta, \quad \text{Rs} = \sin 2R, \quad \text{Rcm} = 3 - \text{Rcc},$$

$$\text{Ts} = \sin 2\vartheta, \quad \text{Tc} = \cos 2\vartheta.$$

Численное интегрирование показывает, что система уравнений (15) хорошо описывает эффект анизотропии усиления, наведенной линейно поляризованным излучением накачки, который наблюдался в эксперименте [15]. Суть этого эффекта поясняет рис.5, где показаны зависимости коэффициентов усиления U_1, U_2 и интенсивностей

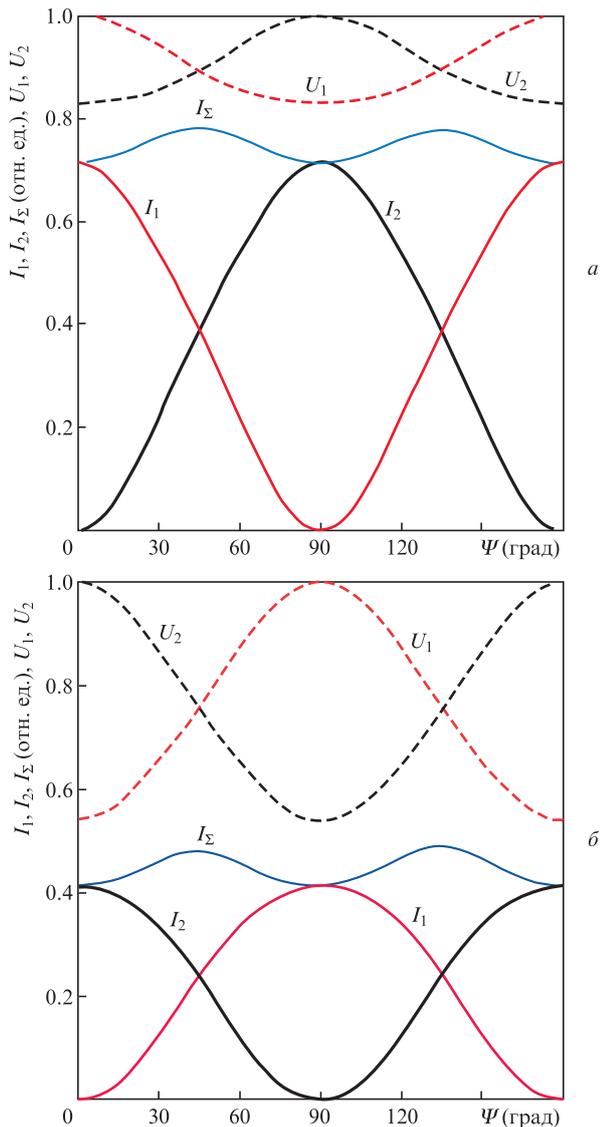


Рис.5. Зависимости интенсивностей поляризационных мод I_1 , I_2 , I_Σ и коэффициентов усиления U_1 , U_2 от ориентации поляризации накачки в случае учета только одного типа поглощающего перехода при $b_1^0 = 0$, $b_2^0 = 0.002$ (а) и $b_1^0 = 0.002$, $b_2^0 = 0$ (б), $G = 1000$, $A = 2.5$, $\vartheta = 0$, $R = 0$.

I_1 , I_2 ортогональных мод, а также их суммы I_Σ от ориентации поляризации накачки. Представлены два случая, когда в процессе поглощения накачки участвуют только σ -переходы (рис.5,а) и только π -переходы (рис.5,б). В обоих случаях четко видна анизотропия усиления ($U_1 \neq U_2$), проявляющаяся в противофазном изменении интенсивностей ортогонально поляризованных мод, с той лишь разницей, что при одной и той же ориентации поляризации накачки преимущество имеет ортогональная мода.

3. Поляризационная нестабильность

Особенностью предложенной модели является наличие двух ортогональных каналов поглощения накачки на π - и σ -переходах. По отдельности каждый из каналов хорошо описывает наблюдающийся экспериментально эффект наведенной анизотропии усиления. Исследования показывают, что совместное действие этих каналов накачки может приводить к нестационарному режиму генерации, проявляющемуся в возникновении противофаз-

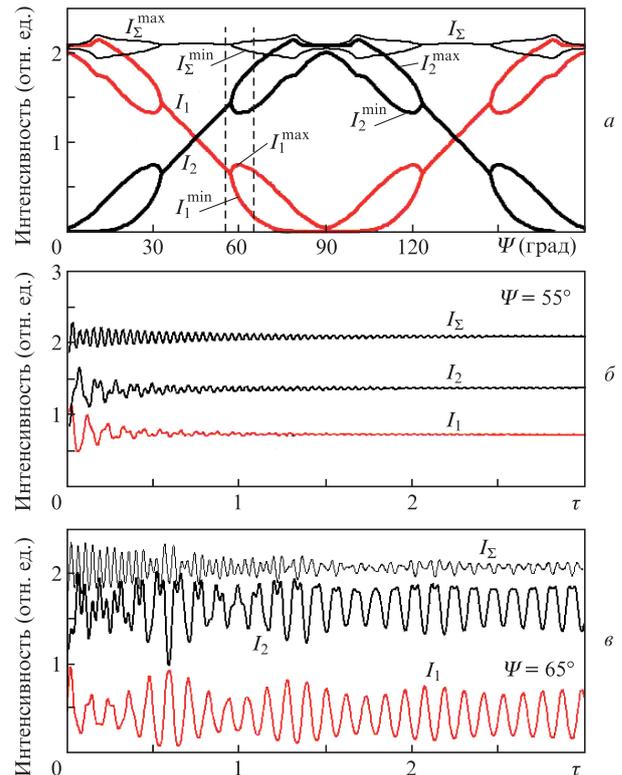


Рис.6. Зависимости интенсивностей поляризационных мод от ориентации поляризации излучения накачки в случае совместного действия каналов накачки при $b_1^0 = 0.0043$, $b_2^0 = 0.024$ (а), переходные процессы, возникающие при небольшом возмущении стационарных значений интенсивностей мод (б), и осциллограммы интенсивностей мод в автомодуляционном режиме при $G = 1000$, $A = 2.5$, $\vartheta = 0$, $R = 0$ (в). Цветной вариант рис.6 помещен на сайте нашего журнала <http://www.quantum-electron.ru>.

ных колебаний интенсивностей поляризационных мод, что демонстрирует рис.6. На рис.6,а приведены интенсивности отдельных поляризационных мод I_1 , I_2 и их сумма I_Σ в зависимости от ориентации поляризации накачки. Нестационарный режим генерации отображается здесь зависимостями минимальных и максимальных значений интенсивностей отдельных мод и их суммы. Переход от стационарного режима к нестационарному выглядит как расщепление одной линии на две. На рис.6,б представлены переходные процессы, возникающие при небольшом возмущении стационарных значений интенсивностей мод. Эти рисунки четко демонстрируют наличие в системе хорошо известных [22] двух типов релаксационных колебаний: высокочастотных синфазных колебаний, которые явно проявляются в суммарной интенсивности, и низкочастотных противофазных колебаний, четко проявляющихся в поведении отдельных поляризационных мод. На рис.6,в приведены типичные осциллограммы интенсивностей мод в автомодуляционном режиме. Сравнение рис.6,б и в показывает, что частота противофазных автомодуляционных колебаний близка к частоте низкочастотных релаксационных колебаний.

4. Заключение

Таким образом, нами предложена модель, учитывающая реальные ориентации поглощающих и излучающих дипольных моментов в элементарной ячейке монокристалла Nd:YAG. Она адекватно описывает эффект наведе-

денной анизотропии усиления линейно поляризованным излучением накачки, проявляющийся в противофазном изменении интенсивностей ортогонально поляризованных мод и наблюдавшийся в экспериментах [15].

Предложенный подход к описанию поляризационных свойств Nd:YAG-лазеров дает возможность исследовать влияние на режимы их генерации произвольной ориентации кристаллографических осей кристалла относительно оси резонатора, что позволит найти оптимальные условия для снижения порога и увеличения эффективности генерации лазера.

Кроме того, модель предсказывает новый вид неустойчивости, который обусловлен наличием двух конкурирующих каналов накачки и, насколько нам известно, ранее в литературе не обсуждался. Известные экспериментальные данные по наблюдению эффекта наведенной анизотропии усиления соответствуют результатам, представленным на рис.5, что говорит о реализации в эксперименте только одного из двух каналов накачки. Для экспериментальной проверки предсказаний развитой теории необходимо иметь перестраиваемый по длине волны и ширине полосы излучения лазер накачки, что позволит управлять вкладами поглощающих π - и σ -переходов в процесс возбуждения активной среды Nd:YAG-лазера (см. рис.2).

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках государственного задания ИПФ РАН (проект № 0035-2014-0018).

Приложение

Рассмотрим ионы в грани p . Две оси симметрии, p_1 и p_2 , лежат в плоскости грани p , в то время как третья ось p_3 перпендикулярна ей и направлена вдоль оси X . В собственной системе координат ($X'Y'Z'$) орты линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей, для которых ось квантования ориентирована вдоль параллельной оси Y' диагонали грани p (диагональ 1), можно представить в виде (рис. 1П,а)

$$(e_a^{\pi p_1})' = y^{0r}, \quad (e_a^{\sigma p_1})' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{0r} \pm iz^{0r}). \quad (\text{П1})$$

Преобразуя систему координат $X'Y'Z'$ в нештрихованную систему координат XYZ по закону

$$\begin{aligned} x^{0r} &= x^0, \\ y^{0r} &= y^0 \cos 45^\circ + z^0 \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}(y^0 + z^0), \\ z^{0r} &= -y^0 \cos 45^\circ + z^0 \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}(-y^0 + z^0), \end{aligned} \quad (\text{П2})$$

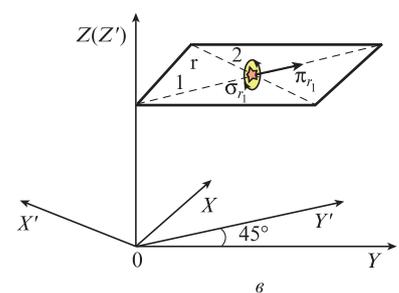
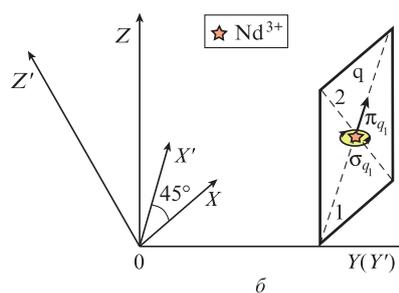
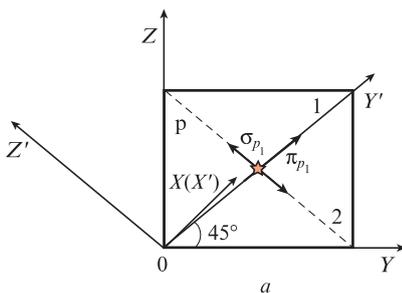


Рис.1П. Ионы Nd^{3+} в гранях p (а), q (б) и r (в).

получаем следующие выражения для ортов первой пары линейно поляризованного и циркулярно поляризованного дипольных моментов в грани p :

$$e_a^{\pi p_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(y^0 + z^0), \quad e_a^{\sigma p_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[x^0 \mp i \frac{1}{\sqrt{2}}(y^0 - z^0)\right]. \quad (\text{П3})$$

Вторая диагональ грани p ориентирована вдоль оси Z' (диагональ 2). В этом случае выражения для ортов линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей можно записать в виде

$$(e_a^{\pi p_2})' = z^{0r}, \quad (e_a^{\sigma p_2})' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{0r} \pm iy^{0r}). \quad (\text{П4})$$

Преобразуя систему координат $X'Y'Z'$ в нештрихованную систему координат XYZ по закону (П2), получаем следующие выражения для ортов второй пары линейно поляризованного и циркулярно поляризованного дипольных моментов в грани p :

$$e_a^{\pi p_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-y^0 + z^0), \quad e_a^{\sigma p_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[x^0 \pm i \frac{1}{\sqrt{2}}(y^0 + z^0)\right]. \quad (\text{П5})$$

Для третьей группы активных центров, расположенных в грани p , собственная система координат совпадает с системой координат XYZ , и поэтому выражения для ортов линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей имеют вид

$$e_a^{\pi p_3} = x^0, \quad e_a^{\sigma p_3} = \frac{1}{\sqrt{2}}(y^0 \pm iz^0). \quad (\text{П6})$$

Аналогично поступаем с активными центрами в гранях q и r .

Рассмотрим ионы в грани q (рис. 1П,б). Две оси симметрии, q_1 и q_2 , лежат в плоскости грани q , в то время как третья ось симметрии q_3 перпендикулярна этой грани и направлена вдоль оси Y . В собственной системе координат $X'Y'Z'$ орты линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей, для которых ось квантования ориентирована вдоль параллельной оси X' диагонали грани q (диагональ 1), можно представить в виде

$$(e_a^{\pi q_1})' = x^{0r}, \quad (e_a^{\sigma q_1})' = \frac{1}{\sqrt{2}}(y^{0r} \pm iz^{0r}). \quad (\text{П7})$$

Преобразуя систему координат $X'Y'Z'$ в нештрихованную систему координат XYZ по закону

$$\begin{aligned} x^{0r} &= x^0 \cos 45^\circ + z^0 \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + z^0), \\ y^{0r} &= y^0, \\ z^{0r} &= -x^0 \cos 45^\circ + z^0 \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x^0 + z^0), \end{aligned} \quad (\text{П8})$$

получаем следующие выражения для ортов первой пары линейно поляризованного и циркулярно поляризованного дипольных моментов в грани q:

$$e_a^{\pi q_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + z^0), \quad e_a^{\sigma q_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[y^0 \mp i \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 - z^0)\right]. \quad (\text{П9})$$

Вторая диагональ грани q ориентирована вдоль оси Z' (диагональ 2). В собственной системе координат $X'Y'Z'$ выражения для ортов линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей можно записать в виде

$$(e_a^{\pi q_2})' = z^{0r}, \quad (e_a^{\sigma q_2})' = \frac{1}{\sqrt{2}}(y^{0r} \pm ix^{0r}). \quad (\text{П10})$$

Преобразуя систему координат $X'Y'Z'$ в нештрихованную систему координат XYZ по закону (П8), получаем следующие выражения для ортов второй пары линейно поляризованного и циркулярно поляризованного дипольных моментов в грани q:

$$e_a^{\pi q_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x^0 + z^0), \quad e_a^{\sigma q_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[y^0 \pm i \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + z^0)\right]. \quad (\text{П11})$$

Для третьей группы активных центров, расположенных в грани q, собственная система координат совпадает с системой координат XYZ , и поэтому выражения для ортов линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей имеют вид

$$e_a^{\pi q_3} = y^0, \quad e_a^{\sigma q_3} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 \pm iz^0). \quad (\text{П12})$$

Рассмотрим ионы в грани r (рис. 1П,б). Две оси симметрии, r_1 и r_2 , лежат в плоскости грани r, а третья ось симметрии r_3 перпендикулярна ей и направлена по оси Z . В собственной системе координат $X'Y'Z'$ орты линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей, для которых ось квантования ориентирована вдоль параллельной оси Y' диагонали грани r (диагональ 1), можно представить в виде

$$(e_a^{\pi r_1})' = y^{0r}, \quad (e_a^{\sigma r_1})' = \frac{1}{\sqrt{2}}(z^{0r} \pm ix^{0r}). \quad (\text{П13})$$

Преобразуя систему координат $X'Y'Z'$ в нештрихованную систему координат XYZ по закону

$$\begin{aligned} x^{0r} &= x^0 \cos 45^\circ - y^0 \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 - y^0), \\ y^{0r} &= x^0 \sin 45^\circ + y^0 \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + y^0), \\ z^{0r} &= z^0, \end{aligned} \quad (\text{П14})$$

получаем следующие выражения для ортов первой пары линейно поляризованного и циркулярно поляризованного дипольных моментов в грани r:

$$e_a^{\pi r_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + y^0), \quad e_a^{\sigma r_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[z^0 \pm i \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 - y^0)\right]. \quad (\text{П15})$$

Вторая диагональ грани r ориентирована вдоль оси X' (диагональ 2). В собственной системе координат $X'Y'Z'$ выражения для ортов линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей можно записать в виде

$$(e_a^{\pi r_2})' = x^{0r}, \quad (e_a^{\sigma r_2})' = \frac{1}{\sqrt{2}}(z^{0r} \pm iy^{0r}). \quad (\text{П16})$$

Преобразуя систему координат $X'Y'Z'$ в нештрихованную систему координат XYZ по закону (П14), получаем следующие выражения для ортов второй пары линейно поляризованного и циркулярно поляризованного дипольных моментов в грани r:

$$e_a^{\pi r_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 - y^0), \quad e_a^{\sigma r_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[z^0 \pm i \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + y^0)\right]. \quad (\text{П17})$$

Для третьей группы активных центров, расположенных в грани r, собственная система координат совпадает с системой координат XYZ , и поэтому выражения для ортов линейно поляризованного (π) и циркулярно поляризованного (σ) диполей имеют вид

$$e_a^{\pi r_3} = z^0, \quad e_a^{\sigma r_3} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 \pm iy^0). \quad (\text{П18})$$

- Owyoung A., Esherrick P. *Opt. Lett.*, **12**, 999 (1987).
- Bielawski S., Derozier D., Glorieux P. *Phys. Rev. A*, **46**, 2811 (1992).
- Leners R., Francois P.L., Stephan G. *Opt. Lett.*, **19**, 275 (1994).
- Lacot E., Stoeckel F., Chenevier M. *Phys. Rev. A*, **49**, 3997 (1994).
- Czarske J.W., Mueller H. *Opt. Commun.*, **114**, 223 (1995).
- Quantum Semiclassical Opt.*, **10**, No. 1 (1998); *J. Opt. B: Quantum Semiclassical Opt.*, **3**, No. 2 (2001).
- Reyzer K.C., Casperson L.W. *J. Appl. Phys.*, **51**, 6083 (1980).
- Tiwari S.K., Mehendale S.C. *Rev. Sci. Instrum.*, **69**, 4245 (1998).
- Hornig M.L., Gardecki J.A., Maroncelli M. *J. Phys. Chem. A*, **101**, 1030 (1997).
- Otsuka K., Mandel P., Bielawski S., Derozier D., Glorieux P. *Phys. Rev. A*, **46**, 1692 (1992).
- Besnard P., Jia X., Dalgliesh R., May A.D., Stephan G. *J. Opt. Soc. Am. B*, **10**, 1605 (1993).
- Хандохин П.А., Ханин Я.И., Мамаев Ю.А., Миловский Н.Д., Широков Е.Ю., Белавски С., Дерозье Д., Глорно П. *Квантовая электроника*, **25**, 517 (1998) [*Quantum Electron.*, **28**, 502 (1998)].
- Khandokhin P.A., Khanin Ya.I., Milovsky N.D., Shirokov E.Yu., Bielawski S., Derozier D., Glorieux P. *Quantum Semiclassical Opt.*, **10**, 97 (1998).
- Khandokhin P.A., Milovsky N.D., Mamaev Yu.A., Ovchinnikov E., Shirokov E.Yu. *Proc. SPIE*, **3682**, 53 (1998); Ievlev I., Khandokhin P., Shirokov E. *Proc. SPIE*, **6265**, 18 (2006).
- Bouwmans G., Segard B., Glorieux P., Milovsky N., Khandokhin P., Shirokov E. *Изв. вузов. Сер. Радиофизика*, **47**, 813 (2004) [*Radio-phys. Quantum Electron.*, **47**, 729 (2004)].
- Khandokhin P. *Proc. SPIE*, **6265**, 131 (2006).
- Zhang Sha., Tan Y., Zhang Shu. *J. Opt.*, **17**, 045703 (2015).
- Chen H., Zhang S., Tan Y. *Appl. Opt.*, **55**, 2858 (2016).
- Arecchi F.T., in *Instabilities and Chaos in Quantum Optics* (Berlin: Springer, 1987, p. 9).
- Shwartz S., Feugnet G., Rebut M., Bretenaker F., Pocholle J.-P. *Phys. Rev. A*, **79**, 063814 (2009).
- De S., Loas G., Amili A.El., Alouini M., Bretenaker F. *J. Opt. Soc. Am. B*, **30**, 2830 (2013).
- Bayerer R., Heber J., Mateika D. *Z. Phys. B*, **64**, 201 (1986).
- San Y., Wang G.M., Cone R.L., Equall R.W., Leask M.J.M. *Phys. Rev. B*, **62**, 15443 (2000).
- Феофилов П.П. *УФН*, **58**, 69 (1956).
- Феофилов П.П., Каплянский А.А. *УФН*, **76**, 201 (1962).
- Зверев Г.М., Голяев Ю.Д. *Лазеры на кристаллах и их применение* (М.: Радио и связь, 1994).
- Esherrick P., Owyoung A. *Proc. SPIE*, **912**, 2 (1988).
- Casperson L.W., Reyzer K.C. *J. Appl. Phys.*, **51**, 6075 (1980).
- Nilsson A.C., Gustafson E.K., Byer R.L. *IEEE J. Quantum Electron.*, **25**, 767 (1989).
- Хандохин П.А., Мамаев Ю.А. *Квантовая электроника*, **41**, 571 (2011) [*Quantum Electron.*, **41**, 571 (2011)].